PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-031371

(43) Date of publication of application: 31.01.2003

(51)Int.CI.

H05B 33/22 H05B 33/14

(21)Application number: 2001-216944

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22)Date of filing:

17.07.2001

(72)Inventor: SATO HIDEKI

SATO YOSHIHARU **ICHINOSAWA AKIKO**

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND BLUE LIGHT EMITTING ELEMENT (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To fully ensure the drive stability of an element in an organic electroluminescent element and to provide the element with high color purity.

SOLUTION: This organic electroluminescent element has a luminescent layer clamped between an anode and a cathode, on a substrate, and a hole blocking layer on the cathode side interface of the luminescent layer. The hole blocking layer contains a compound expressed by a general formula (I). In the formula (I), a carbozolyl group and a phenylene group may have an arbitrary substituent, and Z shows a divalent linkage group.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許山東公開各号 特開2003-31371

(P2003-31371A)

(43)公開日 平成15年1月31日(2003.1.31)

(51) Int.CL?	識別配号	FΙ	ラーマユード(参考)
H05B 33/22		H 0 5 B 33/22	B 3K007
			D
33/14		33/14	В

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全23 頁)

(21)出顯番号	物職2001-216944(P2001-216944)	(71)出願人	000005968
			三菱化学株式会社
(22)出願日	平成13年7月17日(2001.7.17)		東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
		(72) 発明者	佐藤 秀樹
			神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
			三菱化学株式会社内
		(72) 發明者	佐藤
		(/=//6/44	神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
			三菱化学株式会社内
		(74)代理人	100086911
		(14)1代塔(人	***************************************
			弁理士 重野 剛

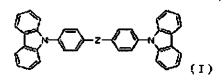
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子及び育色発光素子

(57)【變約】 (修正有)

【課題】 有機電界発光素子において、素子の駆動安定 性を充分に確保すると共に、色純度の良好な素子を提供 する。

【解決手段】 基板上に、陽極および陰極により挟縛された発光層を有し、発光層の陰極側の界面に正孔阻止層を有する有機電界発光素子。正孔阻止層は、下記一般式(I)で表わされる化合物を含有する。



((I) 式中、カルバゾリル基ねよびフェニレン基は任意の置換基を有していてもよい。2は2価の連結基を示す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、陽極および陰極に挟持された 発光層を有し、該発光層の該陰極側の界面に接して正孔 阻止層が設けられた有機電界発光素子において、

該正孔阻止層が、下記一般式(i)で表わされる化台物を含むことを特徴とする有機電界発光素子。

[{tl]

((I)) 式中、R¹~R¹*は各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換量を有していてもよい芳香族炭化水素環基または芳香族複素環基を表し、R¹とR¹、R※

※'とR'、R'とR'、R'とR'、R'とR''、R''と R''、R''とR''、R''とR''はそれぞれ結合して環を 形成してもよい。2は2個の連絡基を示す。)

* ((I)式中、カルバゾリル基およびフェニレン墓は任

意の置換基を有していてもよく、また該置換基同士が結

合し、カルバゾリル基またはフェニレン基に縮合する環

【請求項2】 一般式(1)で表される化合物が、下記

一般式(i) で表されることを特徴とする請求項1に

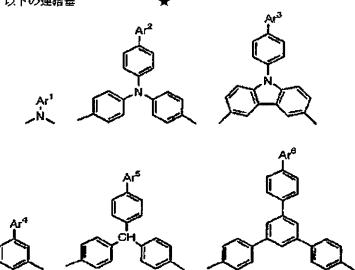
を形成していてもよい。2は2価の連結基を示す。)

記載の有機電界発光素子。

【請求項3】 一般式(I)または(I')における2が、以下に示す連結基、

[{£3]

置換基を有してもよい2個の芳香族炭化水素環基または ★【化4】 芳香族復素環基、或いは、以下の連結基 ★



(上記各構造中のベンゼン環部分は、いずれも任意の置換基を有していてもよく、また式中、Ar¹~Ar²は置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基または芳香族複素環基、或いは、以下に示す一般式(II) 【化5】

で表される基のいずれかである。なお、式(II)中、カルバブリル基およびフェニレン基は任意の置換基を有していてもよい。)のいずれかで表される構造であることを特徴とする請求項1または2に記載の有機電界発光素子。

【請求項4】 一般式(II)で表される構造が、下記一般式(II))で表される構造であることを特徴とする請求項3に記載の有機電界発光素子。

[1Ł6]

((II')式中、R**~R**は各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、置換基を有していてもよいアミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基または芳香族復素環基を表し、R**とR**、R**とR**、R**とR**、R**とR**、R**とR**、R**とR**、R**とR**、R**とR**、R***

【請求項5】 該正孔阻止層のイオン化ポテンシャルが 発光層のイオン化ポテンシャルより①. 1 ev以上大きい ことを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記 載の有機電界発光素子。

【請求項6】 該正孔阻止層と陰極との間に電子輸送層 を有することを特徴とする請求項1ないし5のいずれか 1項に記載の有機電界発光素子。

【請求項7】 該発光層と陽極との間に正孔輸送層を有すること特徴とする請求項1ないし6のいずれか一項に 記載の有機電界発光素子。

【請求項8】 請求項1ないし7のいずれか1項に記載 の有機電界発光素子よりなる青色発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機電界発光素子及び青色発光素子に関するものであり、詳しくは、有機化 台物から成る発光層に電界をかけて光を放出する薄膜型 デバイスに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、薄膜型の電界発光(EL)素子としては、無機材料のII-VI族化台物半導体であるZnS、CaS、SrS等に、発光中心であるMnや希土類元素(Eu、Ce、Tb、Sn等)をドープしたものが一般的であるが、上記の10 無機材料から作製したEL素子は、

- 1)交流駆動が必要(50~1000Hz)。
 - 2)駆動電圧が高い (~200V)、
 - 3) フルカラー化が困難 (特に青色).
 - 4) 周辺駆動回路のコストが高い、

という問題点を育している。

【0003】しかし、近年、上記問題点の改良のため、 有機薄膜を用いたEL素子の開発が行われるようになっ た。特に、発光効率を高めるため、電極からのキャリア 一注入の効率向上を目的として電極の種類の最適化を行 い、芳香族ジアミンから成る正孔輸送層と8-ヒドロキシ キノリンのアルミニウム語体から成る発光層とを設けた 有機電界発光素子の関発(Appl、Phys、Lett., 51巻、9 13頁、1987年)により、従来のアントラセン等の単結晶 を用いたEL素子と比較して発光効率の大幅な改善がなさ れている。また、例えば、8-ヒドロキシキノリンのアル ミニウム錯体をホスト材料として、クマリン等のレーザ 一用蛍光色素をドープすること(J. Appl、Phys., 65巻、 3610頁、1989年)で、発光効率の向上や発光波長の変 換等も行われており、実用特性に近づいている。

【0004】上記の様な低分子材料を用いた電界発光素子の他にも、発光層の材料として、ボリ(p-フェニレンビニレン)、ボリ [2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン]、ボリ (3-アルキルチオフェン)等の高分子材料を用いた電界発光素子の開発や、ボリビニルカルバゾール等の高分子に低分子の発光材料と電子移動材料を複合した素子の開発も行われている。

【0006】また、小型文字表示素子への応用という点では、主として、単純マトリクス駆動法が採用される。 この方法では、高デューティ比で素子を極めて短時間で 50 発光させるため、素子に発生する熱に対しては有利であ

るが、非常に高輝度で発光させる必要があり、そのため 寿命低下が促進されるという問題がある。

【0007】とれまでに報告されている有機電界発光素 子では、基本的には正孔輸送層と電子輸送層との組み合 わせにより発光を得ている。この素子では、陽極から注 入された正孔は正孔輸送層を移動し、陰極から注入され て電子輸送層を移動してくる電子と、両層の界面近傍で 再結合し、正孔輸送層および/または電子輸送層を励起 させて発光させるのが原理である。近年では正孔輸送層 と電子輸送層との間に発光層を設けることにより、発光 10 効率を向上させている素子が一般的である。

【0008】さらに、発光層中での励起子生成を促進さ せ、発光の高効率化と発光色の高純度化を目的に、発光 層と電子輸送層との間に正孔阻止層を設けることがあ る。特に、青色発光素子では一般的である。これらの正 孔阻止層に関して、発光層と陰極との間に設けられる、 発光層のイオン化ポテンシャルよりもり、 Lev以上大き なイオン化ポテンシャルを有する正孔阻止層として、ト リス(5,7-ジクロル-8-ヒドロキシキノリノ)アルミニ ウム (特開平2-195683号公報) や、シラシクロペンタ ジエン(特関平9- 87616号公報)よりなる正孔阻止層を 設けた素子が提案されているが、駆動安定性は十分では なかった。この駆動劣化の要因としては、材料のガラス 転移温度(Tg)が低い事に由来する熱劣化や、電子や 正孔の注入により材料が還元・酸化されてしまう電気化 学的妄因などが考えられている。

【0009】有機電界発光素子において、高発光効率か つ安定な素子を作製するためには、陰極から注入された 電子を効率よく発光層に輸送すること。 および 発光層 を通過する正孔を阻止することが必要であり、そのため の素子構造および材料に対して、更なる改良検討が望ま れていた。

【0010】なお、特闘平8-60144号公報には 4、4 - シ(N-カルバゾリル) ピフェニルを含む層 を、陰極界面層として用いた有機電界発光素子が記載さ れているが、N-フェニルカルバゾール基を有する特定 構造の化合物が優れた正孔阻止作用を有することは、何 **ら記載されていない。**

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、陰極から注 40 入された電子を効率よく発光層に輸送することができ、 また、発光層を通過する正孔を確実に阻止することがで き、しかも耐熱劣化や電気化学的安定性にも優れた正孔 阻止層を有し、従って、目的とする発光色を高い色純度 で高効率に発光することが可能であり、更には駆動安定 性にも優れた有機電界発光素子及び青色発光素子を提供 することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の有機電界発光素 子は、基板上に、陽極および陰極に挟持された発光層を 50 の置換基を有していてもよいが、その置換基としては、

有し、該発光層の該陰極側の界面に接して正孔阻止層が 設けられた有機電界発光素子において、該正孔阻止層 が、下記一般式(!)で表わされる化合物を含むことを 特徴とする。

[0013]

[化?]

【0014】(弐中、カルバゾリル基およびフェニレン 基は任意の置換基を有していてもよく、また該置換基同 士が結合し、カルバゾリル基またはフェニレン量に縮合 する頃を形成していてもよい。2は2個の連結量を示 す。)

【0015】本発明の青色発光素子は、このような本発 明の有機電界発光素子よりなるものである。

【①①16】即ち、本発明者らは、上記目的を達成すべ 20 く鋭意検討した結果、正孔阻止層の材料として、上記特 定の化合物を用いることで本発明の目的を達成し得るこ とを見出し、本発明を完成するに至った。

【①①17】本発明の青色発光素子は、このような本発 明の有機電界発光素子よりなるものである。

【①①18】正孔阻止麿を構成する材料は、発光層中の 発光に寄与する物質のイオン化ポテンシャル(後述する ように、発光層がポスト材料とドーパントを含んでいる 場合には、ホスト材料のイオン化ポテンシャル)よりも 0. 1eV以上大きなイオン化ポテンシャルを有すること が好ましい。また、安定な藻膜形状を与え、高いガラス 転移温度(Tg)を有し、電子を効率よく輸送すること ができる化合物であることが必要である。さらに電気化 学的かつ化学的に安定であり、トラップとなったり発光 を消光したりする不純物が製造時や使用時に発生しにく い化合物であることが要求される。

【0019】前記一般式(I)で表されるN-フェニル カルバゾール骨格を有する化合物であれば、このような 要求特定をすべて満たし、従って、目的とする発光色を 高い色純度で高効率に発光することが可能であり、更に は駆動安定性にも優れた有機電界発光素子を真現するこ とができる。

[0020]

30

【発明の実施の形態】以下に、本発明の有機電界発光素 子及び青色発光素子の実施の形態を詳細に説明する。

【①①21】まず、本発明の有機電界発光素子におい で、正孔阻止層を模成する前記一般式(1)で表される 化合物について説明する。

【10022】前記一般式(1)で表される化合物は、そ のカルバゾリル基および/またはフェニレン基上に任意

本発明の基本特性に悪影響を及ぼさないものであれば、 どのような置換基でもかまわない。また、該置換基同士 で環を形成していてもよい。

【10023】前記一般式(1)で表される化合物は、好米

*ましくは下記一般式(!))で表される。 [0024] [fk8]

【0025】((!゚)式中、R*~R*%は各ャ独立 に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル 基。アルケニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、ア ルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシー 基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアル キル基、水酸基、アリールオキシ基、置換基を有してい てもよい芳香族炭化水素環基または芳香族復素環基を表 R10. R11 & R14. R11 & R14. R14 & R14 & R14 & R14. 結合して環を形成してもよい。2は2個の連結基を示 す。)

【0026】(【*) 式中のR*~R**として、具体的 には水素原子、塩素原子、フッ素原子などのハロゲン原 子;メチル基。エチル基等の炭素数1~6のアルキル 基:ベンジル基等のアラルキル基:ビニル基等の炭素数 2~6のアルケニル基:シアノ基:アミノ基:アシル 基;メトキシカルボニル墓。エトキシカルボニル墓等の 炭素数2~6のアルコキシカルボニル墓;カルボキシル 30 クロヘキサン頌等の5~7員環を形成してもよい。 基:メトキシ蟇、エトキシ蟇等の炭素数1~6のアルコ キシ蟇:ジェチルアミノ蟇、ジイソプロピルアミノ基等。 のジアルキルアミノ基;ジベンジルアミノ基、ジフェネ チルアミノ基などのジアラルキルアミノ基:トリフルオ ロメチル基等のαーハロアルキル基;水酸基;フェノキ シ基。ベンジルオキシ基などのアリールオキシ基:體機※

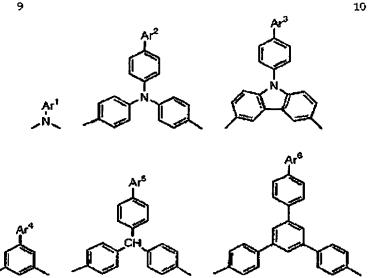
※基を育していてもよいフェニル基、ナフチル基等の芳香 族炭化水素環基:置換基を有していてもよいチエニル 基、ビリジル基等の芳香族複素環基が挙げられる。

【10027】前記芳香族炭化水素環基および芳香族復素 **環基が有し得る置換基としては、フッ素原子等のハロゲ** ン原子:メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキ ル基:ビニル基等の炭素数2~6のアルケニル基:メト し、R* とR* 、R* とR*、R* とR*、R* とR*、R* と 20 キシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数2 ~6のアルコキシカルボニル基;メトキシ基、エトキシ 基等の炭素数1~6のアルコキシ基;フェノキシ基、ベ ンジルオキシ基などのアリールオキシ基、ジメチルアミ ノ蟇、ジエチルアミノ基等のアルキルアミノ基;アセチ ル基等のアシル基:トリフルオロメチル基等のハロアル キル基:シアノ基などが挙げられる。

> [0028]なお、R'とR'、R'とR'、R'とR ° . R' &R° . R° &R¹⁰, R¹¹&R¹¹, R¹1 &R 11 、R11 とR10 はそれぞれ結合し、ベンゼン環、シ 【0029】R*ないしR**として特に好ましいのは、 水素原子、アルキル基、またはシアノ基である。 【 () () (3 () 】一般式(I)または(I))における2とし で、好ましくは以下に示す連結基、 【化9】

置換基を有していてもよい2価の芳香族炭化水素環基ま たは芳香族復素環基、または、以下の連結基のいずれか が挙げられる。

[0031] 【化10】



【0032】(上記樽造中のペンゼン環部分は、いずれ も任意の置換基を有していてよく、またA r ?~A r %は 香族複素環基。または以下の一般式(II)で表される基 が挙げられる。

【化11】

なお、式(II)中におけるカルバゾリル基およびフェニ レン基は、任意の置換基を有していてもよい。)

【0033】一般式(i)または(I')における2の 芳香族炭化水素環基としては、例えばフェニレン基、ナ フチレン基、アントラセン基、ナフタセン基等、5また は6員環の単環または2~4縮合環が挙げられる。2の 芳香族復素環基としては、例えばチオフェン基。フラン 基。ピリジン基。ピリミジン基、キノリン基等。5また は6員環の単環または2~3縮台環が挙げられる。

【①①34】これらの芳香族炭化水素源基および芳香族 復素環基はいずれも置換基を有していてもよく、該置換米

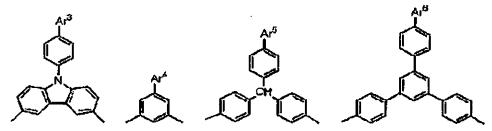
*基としては、例えばメチル基、エチル基等の炭素数1~ 6のアルキル基、フッ素原子等のハロゲン原子、トリフ 置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基または芳 20 ルオロメチル基等の炭素教1~6のα-ハロアルキル基 等が挙げられる。

> 【0035】Ar! ~Ar* としては、フェニル基、ナ フチル基、アントラニル量、ナフタセン基等の、5また は6員環の単環または2~4縮台環である芳香族炭化水 素環基、チエニル基、フリル基、ピリジル基、ピリミジ ル基、キノリル基等の、5または6員項の単環または2 ~3福台環である芳香族複素環基が挙げられる。これら はいずれも、メチル基、エチル基等の炭素数1~6のア ルキル基、フッ素原子等のハロゲン原子、トリブルオロ 30 メチル基等の炭素数1~6のα-ハロアルキル基等の置 換塞を有していても良い。

【0036】一般式(1)または(1)) における2 は、正孔阻止性の観点から、置換基を有していてもよい フェニレン基。ナフチレン基、アントラセン基。チオフ ェン基、フラン基、または、以下の連結基のいずれかで あることが、さらに好ましい。

[0037]

[(t12)



【0038】(上記各構造中のベンゼン環部分は、いず れも任意の置換基を有していてもよく、また、Aェ'~ Ar[®]は置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基

または芳香族複素環基、または以下に示す式(II) [ft13]

50

で表される基のいずれかである。なお、式(II)中にお けるカルバゾリル基およびフェニレン基は、任意の置換 基を有していてもよい。)

【()()39】さらに、式(II)で表される構造は、好き しくは下記式(II))で表される。

[0040]

[化14]

【① 0.4.1】 ((II') 式中、R''~R''は各々独立 に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル 基。アルケニル基、シアノ基、置換基を有していてもよ いアミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基。カル ボキシル基、アルコキシ蟇」アルキルアミノ基」アラル キルアミノ基。ハロアルキル基、水酸基、アリールオキ シ基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素源基ま たは芳香族復素環基を表し、R**とR**、R**とR**、 RileRil RileRilはそれぞれ隣接する置換墓同士 で類を形成してもよい。)

【0042】上記(II') 式において、R**~R**とし で、具体的には、水素原子;ハロゲン原子;メチル基、 エチル基等の炭素数1~6のアルキル基;ベンジル基等 のアラルキル基:ビニル基等の炭素数2~6のアルケニ ル墓;シアノ墓;アミノ墓;アシル墓;メトキシカルボ ニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数2~6のアル コキシカルボニル基:カルボキシル基:メトキシ基、エ トキシ基等の炭素数1~6のアルコキシ基:ジエチルア ミノ基、ジイソプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ 基: ジベンジルアミノ基。ジフェネチルアミノ基などの 49 ジアラルキルアミノ基;トリフルオロメチル基等のα-ハロアルキル墓;水酸基;フェノキシ墓、ベンジルオキ シ基などのアリールオキシ基:置換基を有していてもよ いフェニル基。ナフチル基等の芳香族炭化水素環基:置 **換基を有していてもよいチエニル基。ビリジル基等の芳** 香族複素環基が挙げられる。

【① 043】前記芳香族炭化水素深基および芳香族復素 環基が有し得る置換基としては、フッ素原子等のハロゲ ン原子: メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキ ル基;ビニル基等の炭素数2~6のアルケニル基;スト 50 キシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数2 ~6のアルコキシカルボニル基:メトキシ基、エトキシ 基等の炭素数1~6のアルコキシ基:フェノキシ蟇、ベ ンジルオキシ基などのアリールオキシ基;ジメチルアミ ノ蟇、ジエチルアミノ基等のジアルキルアミノ蟇、アセ チル基等のアシル基:トリフルオロメチル基等のハロア ルキル基:シアノ基などが挙げられる。

[0044]なおR**とR**、R**とR**、R**と R**、R**とR**はそれぞれ結合して、ベンゼン環やシ 10 クロヘキサン頃などの5~7員環を形成してもよい。 【0045】R**ないしR**として特に好ましいのは、 水素原子、アルキル基、またはシアノ基である。

【①①46】前記一般式(I)で表わされる化合物の好 ましい具体例を以下に示すが、これらに限定するもので はない。

[0047]

【化15】

20

[0048] [化16]

(8)

13

[0049] [(t17]

[0050] [4:18]

20

[0051] [ft19]

[0052]

[0053]

[fb21]

[0054]

[0055] [化23]

[0057] [他25]

[0058]

[126]

【0059】以下、本発明の有機電界発光素子の構造に ついて、図面を参照しながら説明する。

【0060】図1~3は本発明の有機電界発光素子の実 施の形態を模式的に示す断面図であり、1は基板、2は 陽極、3は陽極バッファ層、4は正孔輸送層、5は発光 層、6は正孔阻止層、7は電子輸送層、8は陰極を各々 表わす。

【10061】基板1は有機電界発光素子の支持体となる ものであり、石英やガラスの板、金属板や金属箔。プラ スチックフィルムやシートなどが用いられる。特にガラ ス板や、ポリエステル、ポリメタクリレート、ポリカー ボネート、ポリスルホンなどの透明な合成樹脂の板が好 ましい。台成樹脂基板を使用する場合にはガスバリア性 に留意する必要がある。墓板のガスバリア性が小さすぎ ると、基板を通過した外気により有機電界発光素子が劣 化することがあるので好ましくない。このため、合成樹 **脳基板の少なくとも片面に緻密なシリコン酸化膜等を設** けてガスバリア性を確保する方法も好ましい方法の一つ である。

は正孔輸送層4への正孔注入の役割を果たすものであ る。この陽極2は、通常、アルミニウム、金、銀、ニッ ケル、パラジウム、白金等の金属、インジウムおよび/ またはスズの酸化物などの金属酸化物。ヨウ化銅などの ハロゲン化金属。カーボンブラック。あるいは、ポリ (3-メチルチオフェン) ポリピロール、ポリアニリン 等の導電性高分子などにより構成される。 陽極2の形成 は通常、スパッタリング法、真空蒸着法などにより行わ れることが多い。また、銀などの金属微粒子、ヨウ化銅 40 などの微粒子。カーボンブラック、導電性の金属酸化物 微粒子、導電性高分子微粉末などを用いる場合には、適 当なバインダー樹脂溶液に分散し、基板1上に塗布する ことにより陽便2を形成することもできる。さらに、導 電性高分子の場合は、電解重合により直接基板1上に薄 膜を形成したり、基板1上に導電性高分子を塗布して陽 極2を形成することもできる(Appl. Phys. Lett., 60 巻、2711頁、1992年》。

【0063】また、陽極2は異なる材料からなる層を積 層して形成された積層構造であってもよい。

【0062】基板1上には陽極2が設けられる。陽極2 50 【0064】陽極2の厚みは、必要とする透明性により

輸送層4中の含有量で50重量%以下が好ましい。

異なる。透明性が必要とされる場合は、可視光の透過率 を、通常、60%以上、好ましくは80%以上とすることが 望ましく、この場合、厚みは、通常、5~1000mm、好ま しくは10~500nm程度である。不透明でよい場合は陽極 2の厚みは基板1と同程度でもよい。また、さらには上 記の陽極2の上に異なる導電材料を積層することも可能 である。

【0065】陽極2の上には正孔輸送層4が設けられ る。正孔輸送層4の材料に要求される条件としては、陽 極2からの正孔注入効率が高く、かつ、注入された正孔。10 を効率よく輸送することができる材料であることが挙げ られる。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さ く、可視光の光に対して透明性が高く、しかも正孔移動 度が大きく、さらに安定性に優れ、トラップとなる不絶 物が製造時や使用時に発生しにくいことが要求される。 また、発光層5に接するために発光層5からの発光を消 光したり、発光層与との間でエキサイブレックスを形成 して効率を低下させないことが求められる。上記の一般 的要求以外に、車載表示用の応用を考えた場合。素子に はさらに耐熱性が要求されるため、Tgとして85℃以 20 上の値を有する材料が塑ましい。

【0066】とのような正孔輸送材料としては、例え は、4,4'-ビス [N- (1-ナフチル) -N-フェニルアミノ] ビフェニルで代表される2個以上の3級アミンを含み2 個以上の縮合芳香族環が窒素原子に置換した芳香族シア ミン(特関平5 - 234681号公報)、4,41,4″-トリス(1-ナフチルフェニルアミノ)トリフェニルアミン等のスタ ーバースト構造を有する芳香族アミン化合物(J. Lumi n., 72-74巻、985頁、1997年)、トリフェニルアミンの 四量体から成る芳香族アミン化合物(Chem.Commun.. 21 30 75頁、1996年)、2,2'.7,7'-テトラキス-(ジフェニルア ミノ)-9,9'-スピロピフルオレン等のスピロ化合物(Syn th、Metals, 91巻、209頁、1997年)等が挙げられる。 これらの化合物は、単独で用いてもよいし、必要に応じ て、各々、復合して用いてもよい。

【0067】上記の化合物以外に、正孔輸送層4の材料 として、ポリビニルカルバゾール、ポリビニルトリフェ ニルアミン(特開平7- 53953号公報)、テトラフェニ ルベンジジンを含有するポリアリーレンエーテルサルボ ン(Polym、Adv、Tech., 7巻、33頁、1996年)等の高分 40 子材料も挙げられる。

【りり68】正孔輸送層4を塗布法で形成する場合は、 正孔輸送材料の1種または2種以上に、必要により正孔。 のトラップにならないバインダー樹脂や塗布性改良剤な どの添加剤を添加し、溶解して塗布溶液を調製し、スピ ンコート法などの方法により陽極2上に塗布し、乾燥し て正孔輸送層4を形成する。バインダー樹脂としては、 ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル等が 挙げられる。バインダー樹脂は添加量が多いと正孔移動 度を低下させるので、少ない方が望ましく、通常、正孔 50 色素が使用できる。青色発光を与える蛍光色素として

【0069】正孔輸送層4を真空蒸着法で形成する場合 には、正孔輸送材料を真空容器内に設置されたルツボに 入れ、真空容器内を適当な真空ポンプで10^{-- *} Pa程度に まで排気した後、ルツボを加熱して、正孔輸送材料を蒸 発させ、ルツボと向き合って置かれた。陽極2が形成さ れた墓板1上に正孔輸送層4を形成させる。

34

【0070】正孔輸送層4の膜厚は、通常、5~300nm、 好ましくは 10~100nmである。このように薄い膜を一様 に形成するためには、一般に真空蒸着法がよく用いられ

【①①71】正孔輸送層4の上には発光層5が設けられ る。発光層5は、電界を与えられた電極間において、陽 極2から注入されて正孔輸送層4を移動する正孔と、陰 極8から注入されて正孔阻止層6を移動する電子との再 結合により励起されて強い発光を示す電光性化合物より 形成される。

【①①72】発光層5に用いられる蛍光性化合物として は、安定な薄膜形状を有し、固体状態で高い蛍光収率を 示し、正孔および/または電子を効率よく輸送すること ができる化合物であることが必要である。さらに電気化 学的かつ化学的に安定であり、トラップとなる不純物が 製造時や使用時に発生しにくい化合物であることが要求 される。

【りり73】このような条件を満たす材料としては、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体などの金属錯体 (特開昭59-194393号公報)、10-ヒドロキシベンゾ(h) キノリンの金属錯体(特開平6-322362号公報)。 ビスス チリルベンゼン誘導体(特開平1-245087号公報。同2-22 2484号公報)。ピススチリルアリーレン誘導体(特開平 2-247278号公報)、(2-ヒドロキシフェニル)ベンゾチア ゾールの金属錯体(特関平8-315983号公報)、シロール 誘導体等が挙げられる。また、前述の正孔輸送層材料の **うち、蛍光性を有する芳香族アミン系化合物も発光層材** 料として用いることができる。

【0074】これらの発光層材料は、通常は真空蒸着法 により正孔輸送層上に續層されて発光層5が形成され

【0075】発光層5の驥厚は、通常3~200 nm、好ま しくは5~100 nmである。

【0076】発光層も正孔輸送層と同様の方法で形成す ることができるが、通常は真空蒸着法が用いられる。

【()()77】素子の発光効率を向上させるとともに発光 色を変える目的で、例えば、8-ヒドロキシキノリンのア ルミニウム錯体をポスト材料として、クマリン等のレー ザー用蛍光色素をドープすること (). App 1、Phys., 65 巻、3610頁、1989年)等が行われている。このドーピン グ手法は、発光層5にも適用することができ、この場合 のドープ用材料としては、クマリン以外にも各種の営光

は、ペリレン、ピレン、アントラセン、クマリンおよび それらの誘導体等が挙げられる。緑色蛍光色素として は、キナクリドン誘導体、クマリン誘導体等が挙げられ る。黄色蛍光色素としては、ルブレン、ペリミドン誘導 体等が挙げられる。赤色蛍光色素としては、DDAK化合 物。ベンゾピラン誘導体。ローダミン誘導体、ベンゾチ オキサンテン誘導体、アザベンゾチオキサンテン等が挙 げられる。

【0078】上記のドープ用蛍光色素以外にも、ホスト 材料に応じて、レーザー研究、8巻、694頁、803頁、958 10 い。正孔阻止層は、前記一般式(1)で表される化合物 頁(1980年):同9巻、85頁(1981年)、に列挙されて いる蛍光色素が発光層用のドーフ材料として使用するこ とかできる。

【0079】ホスト材料に対して上記蛍光色素がドープ される置は、10°1~10重量%が好ましい。

【0080】上述の蛍光色素を発光層のポスト材料にド ープする方法を以下に説明する。

【①①81】塗布法で発光層を形成する場合は、前記発 光層ポスト材料と、ドープ用蛍光色素。さらに必要によ り電子のトラップや発光の消光剤とならないバインダー 20 樹脂や、レベリング剤等の塗布性改良剤などの添加剤を 添加し、溶解した塗布溶液を調製し、スピンコート法な どの方法により正孔輸送層4上に塗布し、乾燥して発光 層5を形成する。ここでパインダー樹脂としては、ポリ カーボネート、ポリアリレート、ポリエステル等が挙げ られる。バインダー樹脂は添加量が多いと正孔/電子移 動度を低下させるので、少ない方が望ましく、発光層5 中の含有量で50重量%以下が好ましい。

【0082】真空蒸着法で発光層を形成する場合には、 前記ホスト材料を真空容器内に設置されたルツボに入 れ、ドープする蛍光色素を別のルツボに入れ、真空容器 内を適当な真空ポンプで10¹Pa程度にまで排気した後、 各々のルツボを同時に加熱して蒸発させ、ルツボと向か い合って置かれた基板の正孔輸送層4上に層を形成す る。また、他の方法として、上記の材料を予め所定比で 復合したものを同一のルツボに入れて蒸発させてもよ ردن

【0083】上記各ドーパントが発光層5申にドープさ れる場合、通常は発光層5の膜厚方向において均一にド ープされるが、 膜厚方向において濃度分布があっても構 40 わない。例えば、正孔輸送層4との界面近傍にのみドー プしたり、逆に、正孔阻止層6との界面近傍にのみドー プしてもよい。

【0084】正孔阻止層6は発光層5の上に、発光層5 の陰極側の界面に接するように積層される。正孔阻止層 6は、正孔輸送層4から移動してくる正孔が陰極8に到 達するのを阻止する役割と、陰極8から注入された電子 を効率よく発光層5の方向に輸送することができる化合 物より形成される。正孔阻止層6を構成する材料に求め られる物性としては、電子移動度が高く正孔移動度が低 50 る。

いことが必要とされる。正孔阻止層6は正孔と電子を発 光層 5 内に閉じこめて、発光効率を向上させる機能を有 し、そのために正孔阻止層6のイオン化ポテンシャル は、発光層5のイオン化ポテンシャルよりも0. 1 ex以 上大きいことが望まれる。

36

【10085】本発明では正孔阻止層6の材料として、前 記一般式(1)で表される化合物を用いるが、これらの 化合物は正孔阻止層6中に、1種を単独で用いてもよ く、また必要に応じて2種以上を混合して用いてもよ のみで構成されることが望ましいが、前記一般式(!) で表される化合物以外の物質を含有していてもよい。こ の場合、本発明の効果を確実に得る上で、正孔阻止層6 中の前記一般式(!)で表される化合物の含有量が50 重量%以上であることが好ましく、80重量%以上であ ることがより好ましく、実質的に一般式(!)で表され る化合物のみから形成されている場合が最も好ましい。 【0086】正孔阻止層6の膜厚は、通常、0.3~100n m、好ましくは0.5~50mmである。

【0087】正孔阻止層6も正孔輸送層4と同様の方法 で形成することができるが、通常は真空蒸着法が用いら れる。

【0088】陰極8は、正孔阻止層6を介して発光層5 に電子を注入する役割を果たす。陰極8として用いられ る材料は、前記陽極2に使用される材料を用いることが 可能であるが、効率よく電子注入を行なうには、仕事関 数の低い金属が好ましく、スズ、マグネシウム、インジ ウム、カルシウム、アルミニウム、銀等の適当な金属ま たはそれらの合金が用いられる。具体例としては、マグ 30 ネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金、ア ルミニウムーリチウム合金等の低仕事関数合金電極が挙 げられる。

【()()89】陰極8の膜厚は通鴬、陽極2と同様であ る。

【①①90】低仕事関数金属から成る陰極を保護する目 的で、この上にさらに、仕事関数が高く大気に対して安 定な金属層を積層することは素子の安定性を増す上で好 ましい。この目的のために、アルミニウム、銀、銅、ニ ッケル、クロム、金、白金等の金属が使われる。

【0091】素子の発光効率をさらに向上させることを 目的として、図2に示す如く、正孔阻止層6と陰極8の。 間に電子輸送層?を設けることが考えられる。電子輸送 層?は、電界を与えられた電極間において陰極8から注 入された電子を効率よく正孔阻止層6の方向に輸送する ことができる化合物より形成される。

【10092】従って、電子輸送層7に用いられる電子輸 送性化合物としては、陰極8からの電子注入効率が高 く、かつ、高い電子移動度を有し注入された電子を効率 よく輸送することができる化合物であることが必要であ

【0093】とのような条件を満たす材料としては、8 ーヒドロキシキノリンのアルミニウム語体などの金属錯体(特別昭59-194393号公報)、10-ヒドロキシベンゾ [h]キノリンの金属語体、オキサジアゾール誘導体、ジスチリルビフェニル誘導体、シロール誘導体、3-または5-ヒドロキシブラボン金属語体、ベンズオキサゾール金属語体、ベンブチアゾール金属錯体、トリスベンズイミダゾリルベンゼン(米国特許第5,645,948号)、キノキサリン化合物(特別平6-207169号公報)、フェナントロリン誘導体(特別平5-331459号公報)、2-t-ブチル 10-9,10-N,N'-ジシアノアントラキノンジイミン、n型水素化非晶質炭化シリコン、n型硫化亜鉛、n型セレン化亜鉛などが挙げられる。

【0094】電子輸送層6の膜厚は、通常、5~209nm、 好ましくは10~199 nmである。

【0095】電子輸送層では、正孔輸送層4と同様にして塗布法あるいは真空蒸着法により正孔輸送層6上に積層することにより形成される。通常は、真空蒸着法が用いられる。

【0096】また、正孔注入の効率をさらに向上させ、 20かつ、有機層全体の陽極2への付着力を改善させる目的で、図3に示す如く、正孔輸送層4と陽極2との間に陽極バッファ層3を挿入することも行われている。陽極バッファ層3を挿入することで、初期の素子の駆動電圧が下げると同時に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制される効果が得られる。陽極バッファ層3に用いられる材料に要求される条件としては、陽極2とのコンタクトがよく均一な薄膜が形成でき、熱的に安定、すなわち、融点およびガラス転移温度が高いことが挙げられ、融点としては 300℃以上、ガラス転移温度として 30は 100℃以上が好ましい。さらに、イオン化ポテンシャルが低く陽極2からの正孔注入が容易なこと、正孔移動度が大きいことが挙げられる。

【 0 0 9 7 】 この目的のために、これまでに銅フタロシアニン等のフタロシアニン化合物(特開昭63-295695号公報)、ボリアニリン(Appl. Phys. Lett., 64巻、1245頁,1994年)、ボリチオフェン(Optical Materials、9巻、125頁、1998年)等の有機化合物や、スパッタ・カーボン膜(Synth. Met., 91巻、73頁、1997年)や、バナジウム酸化物、ルテニウム酸化物、モリブデン酸化物 40等の金属酸化物(J. Phys. D, 29巻、2750頁、1996年)が報告されている。

【0098】陽極バッファ層3も、正孔輸送層4と同様にして薄膜形成可能であるが、無機物の場合には、さらに、スパッタ法や電子ビーム蒸者法、プラズマCVD法が用いられる。

【0099】以上の様にして形成される陽極バッファ圏 3の機厚は、通常、3~100mm、好ましくは 5~50mmである。

【① 1 0 0 】 さらに、陰極 8 と 発光層 5 または電子輸送 50 ⁻¹ Pa)、蒸者速度 0.14mm/ 秒で蒸着を行ない、 瞬厚 10 nm

層?との界面にLiF、MaF2、Li2 0等の極薄絶無機(膜厚0.1~5nm)を挿入することも、素子の効率を向上させる有効な方法である(Appl、Phys. Lett., 70巻, 152頁、1997年;特開平10−74586号公報;IEEETrans、Electron、DeVices, 44巻、1245頁、1997年)。

【0101】なお、図1とは逆の構造、すなわち、基板上に除極8、正孔阻止層6.発光層5.正孔輸送層4、 陽極2の順に積層することも可能であり、既述したように少なくとも一方が透明性の高い2枚の基板の間に本発明の有機電界発光素子を設けることも可能である。同様に、図2および図3に示した前記各層構成とは逆の構造に積層することも可能である。更に、図1、図2および図3に示した各層以外にも、陽極または降極と発光層との間に任意の層を有していてもよい。

【0102】本発明は、有機電界発光素子が、単一の素子、アレイ状に配置された構造からなる素子、陽極と陰極がX-Yマトリックス状に配置された構造のいずれにおいても適用することができる。

【0103】本発明の有機電界発光素子によれば、正孔 20 阻止層に特定のN-フェニルカルバゾール骨格を有する 化合物を含有させることにより、色純度が良好で駆動安 定性においても大きく改善された高発光効率の素子が得 られる。本発明によれば、特に、従来困難であった青色 発光素子で安定性に優れた素子が得られることから、フ ルカラーあるいはマルチカラーのパネルへの応用におい て優れた性能を発揮できる。

[0104]

【実施例】次に、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の 95 実施例の記載に限定されるものではない。

【0105】実施例1

図3に示す構造を有する有機電界発光素子を以下の方法で作製した。

【①106】ガラス基板1上にインジウム・スズ酸化物(ITO)透明導電膜を 150m堆積したもの(ジオマテック社製:電子ビーム成機品:シート抵抗15章)を通常のフォトリソグラフィ技術と塩酸エッチングを用いて 2 mm幅のストライブにパターニングして陽極2を形成した。パターン形成した「TO基板を、アセトンによる超音波洗浄、純水による水洗、イソプロビルアルコールによる超音波洗浄の順で洗浄後、窒素プローで乾燥させ、最後に紫外線オゾン洗浄を行って、真空蒸着装置内に設置した。上記装置の粗排気を抽回転ボンブにより行った後、装置内の真空度が2×10°Torr(約2.7×10°Pa)以下になるまで液体窒素トラップを備えた抽拡散ボンブを用いて排気した。

【0107】次いで、上記装置内に配置されたモリブデンボートに入れた以下に示す銅フタロシアニン(結晶形は8型)を加熱して、真空度1.7×10°Torr(約2.3×10⁻¹Pa) 薬量速度0.14mm/株で菜量を行なは、勝厚10mm

の陽極バッファ層3を形成した。

[0108] [(£27]

【0109】次に、上記鉄窗内に配置されたセラミックルツボに入れた。以下に示す、4,4'-ビス [N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ビフェニルをルツボの周囲のタンタル線ヒーターで創熱して蒸着を行った。この時のルツボの温度は、245~260℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度1.3×10° Torr(約1.7×10° Pa)、蒸着速度は0.24mm/秒で膜厚60mmの正孔輸送層4を形成した。

[0110]

[4b28]

[0112]

[(£29]

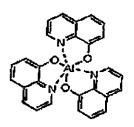
[0113] [(130]

【① 1 1 4 】 さらに、正孔阻止層6 として例示化合物 (H-6) を蒸者速度0.12mm/秒で10mmの機厚で積層した。 蒸着時の真空度は1.1×10 *Torr (約1.5×10 *Pa) であった。発光層5 のホスト化合物と同様に決定した。例示 10 (化合物(H-6)のイオン化ポテンシャルは5.96eVであった。

【0115】次いで、正孔阻止層6の上に、電子輸送層7として以下の構造式に示すアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体、A1(C₆ H₆ ND)。を同様にして蒸着した。との時のアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体のルツボ温度は295~305°Cの範囲で制御し、蒸着時の真空度は8.0×10°Torr(約1.1×10°1Pa)、蒸着速度は0.24mm/秒で膜厚は35mmとした。

[0116]

20 [(E31)



【 ① 1 1 7 】上記の正孔輸送層 4、発光層 5、正孔阻止層 6 および電子輸送層 7 を真空蒸者する時の基板温度は 室温に保持した。

【0118】 ことで、電子輸送層7までの蒸着を行った 素子を一旦前記真空蒸着装置内より大気中に取り出し て、陰極蒸着用のマスクとして 2mm間のストライプ状シャドーマスクを、陽極2のITOストライプとは直交す るように素子に密着させて、別の真空蒸着装置内に設置 して有機層の形成時と同様にして装置内の真空度が2.2 ×10° Torr(約3.0×10° Pa)以下になるまで排気し た

【①119】その後、陰極8として、先ず、フッ化リチ 40 ウム (LiF)をモリブデンボートを用いて、蒸者速度0.0 4nm/秒、真空度4.1×10° Torr (約5.5×10° Pa)で、 0.5nmの膜厚で電子輸送層7の上に成膜した。次に、アルミニウムを同様にモリブデンボートにより加熱して、 蒸着速度0.41mm/秒、真空度9.0×10° Torr (約1.2×10 「Pa)で膜厚100mmのアルミニウム層を形成して陰極8 を完成させた。以上の2層型陰極8の蒸者時の基板温度 は室温に保持した。

【①120】以上の様にして、2mm×2mm のサイズの発 光面積部分を有する有機電界発光素子が得られた。この 第子の発光特性を表1に示す。表1において、発光効率

は 100cd/㎡での値、輝度/電流は輝度-電流密度特性の傾きを、電圧は 100cd/㎡での値を各々示す。安定性は電流密度0.25A/c㎡でDO駆動したとき、初期輝度と60秒後の輝度の比率から評価した。輝度比(60秒後の輝度/初期輝度)が0.98以上を「優れる」、0.90以上0.98未満を「良好」、0.90未満を「劣る」とした。

【0121】素子の発光スペクトルの極大波長は 473nm であり、蛍光色素 (DYE-1) からのものと同定された。また、輝度劣化は殆どなく安定性に優れる。

【0122】比較例1

正孔阻止層を設けず、電子輸送層の機厚を45mmとした他は実施例1と同様に素子を作製した。との素子において、正孔阻止層6のかわりに発光層に接している電子輸送層7を形成している、A1(GH₈ND),のイオン化ポテンシャルは5,41eVであった。との素子の発光特性を表1に示す

【0123】素子の発光スペクトルの極大波長は 514nm で目的とする青色発光は得られず、電子輸送層として用いたアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体からの緑色発光が観測された。

【0124】比較例2

正孔阻止層として以下の構造式に示すシラノールアルミニウムの8-ヒドリキシキノリン錯体(イオン化ポテンシャル: 5.51eV)を用いた他は実施例1と同様に素子を作製した。この素子の発光特性を表1に示す。

【0125】素子の発光スペクトルの極大波長は 473nm で目的とする青色発光が得られたが、輝度劣化が大き く、駆動安定性に欠ける。

[0126]

[fb32]

*【0127】比較例3 正孔阻止層として以下

正孔阻止層として以下の構造式に示す4,4'-N,N'-ジカル パプリルピフェニル(イオン化ポテンシャル:5,93eV) を用いた他は実施例1と同様に素子を作製した。この素 子の発光特性を表1に示す。

42

【0128】素子の発光スペクトルの極大波長は 524nm で目的とする青色発光は得られず、電子輸送層として用いたアルミニウムの&ヒドロキシキノリン錯体からの緑色発光が観測された。

16 [0129]

[fk33]

【0130】実施例2

正孔阻止層として例示化合物 (H-25) を用いた他は実施 20 例1と同様に素子を作製した。この素子の発光特性を表 1 に示す。

【①131】素子の発光スペクトルの極大波長は 471mm で目的とする青色発光が得られ、輝度劣化も少なく駆動 安定性は良好であった。

[0132]

【表1】

*

30

	発光色	最大急光虹度 [cd/m] @0.25A/cm ²	発光効率 []m/W] ❷100cd/m²	輝度/電流 [cd/A]	18€ [V] @100cd/m²	安定位
尖族例1	緑青	\$ 500	1.3	2.0	5.0	優れる
比較例1	黄樑	4800	1.2	2.1	5,4	良鉾
此數例2	経宵	4900	1.5	2.0	5.5	劣る
比較假3	裁黄	2900	0.8	1.4	5.1	良評
实施例2	保育	3300	8.0	1.5	0.6	良好

光素子によれば、任意に選定された発光材料からの発光 のみを得ることが可能であり、さらには駆動安定性に優 れた発光が得ることができる。特に、従来困難であった 青色発光素子の駆動安定性の改善が顕著である。

【①134】従って、本発明による有機電界発光素子は フラットパネル・ディスプレイ(例えばOAコンピュー タ用や壁掛けテレビ〉、車截表示素子、携帯電話表示や 面発光体としての特徴を生かした光源(例えば、複写機 の光源、液晶ディスプレイや計器類のバックライト光 源)、表示板、標識灯への応用が考えられ、その技術的 10 5 発光層 価値は大きいものである。

【図面の簡単な説明】

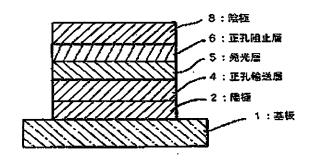
【図1】本発明の有機電界発光素子の実施の形態の一例 を示した模式的断面図である。

*【図2】本発明の有機電界発光素子の実施の形態の別の 例を示した模式的断面図である。

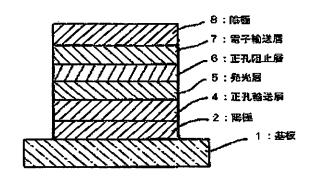
【図3】本発明の有機電界発光素子の実施の形態の別の 例を示した模式的断面図である。

【符号の説明】

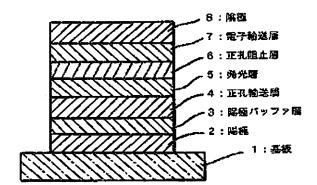
- 1 基板
- 2 陽極
- 3 陽極バッファ層
- 4 正孔翰送層
- 6 正孔阻止層
- 7 電子輸送層
- 8 陰極



[22]



[図3]



(72)発明者 市野澤 晶子 神奈川県衛浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB04 AB06 AB11 BA06 CA01 CB01 DA01 DB03 EB00